

Полупроводниковые пластины, химические вещества и расходные материалы для производства микроэлектроники



Полупроводниковые пластины, слитки

- Пластины/подложки монокристаллического кремния (Si) и германия (Ge)
- Пластины кремния–на–изоляторе (SOI), сапфира (Al₂O₃)
- Полупроводниковые пластины группы A₃B₅ (GaAs, GaN, InP, GaSb, GaP и т.д.)
- Пластины карбида кремния (SiC)
- Слитки кремния и других соединений (Si, SiC, GaAs, LiNbO₃, LiTaO₃, Al₂O₃)
- Foundry–услуги, эпитаксия структур (CVD, MBE), рост кристаллов приборов, литография



Высокочистые химические вещества для производства полупроводников

- Прекурсоры (TEOS, TMGa, TMAI, DETe, TDMAT, TSA, DIPAS, TDSA, TADS, DPDS, PCDS и др.)
- Металлорганические соединения (TMGa, TEGa, TMIIn, TMAI)
- Чистые газы (AsH₃, AGS, PH₃, BF₃, AsH₃, NF₃, др.), металлы (Al, B, Be, Sb, As, Cd, Ga, Ge, Sb, Te)
- Фоторезисты (i/g-Line, ArF, KrF, EUV)
- Антиотражающие покрытия под фоторезист (BARC)



Расходные и сопутствующие материалы

- Фотошаблоны
- Контейнеры, держатели, тара для пластин
- Расходники для CMP–полировки пластин и запасные части оборудования

